# Phase-field 法による Widmanstätten フェライト 形成過程に及ぼす界面異方性の影響評価

神戸大 [院] 〇山中晃徳 神戸大 [海科] 高木知弘 神戸大 [工] 冨田佳宏

# Evaluation of the Effects of Interfacial Anisotropy on the Widmanstätten Ferrite Formation by Phase-field Method Akinori YAMANAKA, Tomohiro TAKAKI and Yoshihiro TOMITA

## 1緒 言

鉄鋼材料の微視組織は広範な温度領域における γ →  $\alpha$ 変態により生成され、多様な形態を有する.  $\gamma \rightarrow \alpha$ 変 態により生成する微視組織としては、Ae3 温度直下にお いてはγ粒界に沿って Allotriomorph フェライトが生成 し、過冷度が増すにつれてラス状もしくはプレート状の Widmanstätten フェライトが形成する. この Widmanstätten フェライトは溶接部の熱影響領域におい て多く観察され、材料の靭性、延性に大きく影響する. したがって、鉄鋼材料のさらなる高機能のためには、y → α 変態による微視組織形成過程の予測を含めた材料 制御技術の向上が重要となる.しかしながら、数多くの 影響因子を有する鉄鋼材料の相変態現象や組織形成過 程を実験的手法のみで解明し、予測することは極めて困 難である. そこで、本研究では代表的な鉄鋼材料である Fe-C 合金の $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態による組織形成過程を Phase-field 法を用いてモデル化し、数値シミュレーションを行うこ とにより $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態により生成される Widmanstätten フ ェライトの形成過程に及ぼす界面異方性の影響につい て詳細に検討する.

# 2 Phase-field モデル

Fe-C合金の全自由エネルギーをα相およびγ相単相 の化学的自由エネルギーと界面が存在することによっ て生じる過剰な自由エネルギーの和として,次式の Gibbsの自由エネルギー汎関数を用いて定義する<sup>1)</sup>.

$$G = \int \left\{ g(\phi, u_C, T) + \frac{\varepsilon(\theta)^2}{2} |\nabla \phi|^2 \right\} dV$$
(1)

ここで、 $\phi$ は $\alpha$ 相において $\phi=1$ 、 $\gamma$ 相において $\phi=0$ の 値をとるphase fieldであり、界面領域において滑らかに 変化する.また、*T* は絶対温度、 $u_c$ は単位体積あたりの 炭素濃度であり、通常の炭素原子のモル分率 $x_c$ を用い て $u_c = ax_c/c(1-x_c)$ で定義される.Fe-C合金の化学的自 由エネルギー密度  $g(\phi,u_c,T)$ は次式で表される.

 $g(\phi, u_{C}, T) = p(\phi)g^{\alpha}(u_{C}, T) + (1 - p(\phi))g^{\gamma}(u_{C}, T) + Wq(\phi)(2)$ 

ここで、 $g^{\alpha}(u_{c},T) \geq g^{\gamma}(u_{c},T)$ は、それぞれ  $\alpha$  相と  $\gamma$  相 単相の自由エネルギー密度である.また、 $p(\phi)$ および  $q(\phi)$ はそれぞれエネルギー密度分布関数、ダブルウェル ポテンシャル、W はエネルギー障壁の高さであり、界面 エネルギー  $\sigma$  および界面幅  $\delta$  を用いて  $W = 6\sigma b/\delta$  で関 連付けられる.なお本研究では、界面領域を  $\lambda \leq \phi \leq 1-\lambda$  と仮定して、 $b=2 \tanh^{-1}(1-2\lambda)$ としている<sup>2)</sup>.

 $\gamma \rightarrow \alpha$ 変態により生成される微視組織形態は,界面エ ネルギーの方位依存性に起因する界面異方性に大きく 影響を受ける.本研究では,強い界面異方性を表現でき る修正勾配エネルギー係数<sup>2) 3)</sup>を用いて, $\varepsilon(\theta)$ に界面エ ネルギー $\sigma$ ,界面厚さ $\delta$ および異方性関数 $\eta(\theta)$ を関係付 けることにより,界面異方性を次式で表現する.

$$\varepsilon(\theta) = \begin{cases} \sqrt{\frac{3\sigma\delta}{b}} \{1 + \gamma \cos k(\theta - \theta_0)\} \equiv \overline{\varepsilon}(\theta) \\ (for \quad 2\pi i/k - \theta_m \le \theta - \theta_0 \le 2\pi (i+1)/k + \theta_m) \\ \frac{\overline{\varepsilon}(\theta_m + \theta_0)}{\cos\theta_m} \cos(\theta - \theta_0) \\ (for \quad 2\pi i/k - \theta_m \le \theta - \theta_0 \le 2\pi i/k + \theta_m) \end{cases}$$
(3)

Phase field  $\phi$  と炭素濃度 $u_c$ の時間発展方程式は、系の 状態は自由エネルギーの減少率が最大になるように変 化するとの仮定に基づき導出され、次式で表される.

$$\frac{\partial\phi}{\partial t} = M_{\phi} \left\{ \nabla \cdot \left\{ \varepsilon(\theta)^2 \nabla \phi \right\} + \frac{\partial g}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial x} \left( \varepsilon(\theta) \frac{\partial \varepsilon(\theta)}{\partial \theta} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \varepsilon(\theta) \frac{\partial \varepsilon(\theta)}{\partial \theta} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right\}$$
(4)

$$\frac{\partial u_{C}}{\partial t} = \nabla \cdot \left\{ L'(\phi, u_{C}, T) \left( \frac{\partial^{2} g}{\partial u_{C}^{2}} \nabla u_{C} + \frac{\partial^{2} g}{\partial u_{C} \partial \phi} \nabla \phi \right) \right\}$$
(5)

ここで、 $M_{\phi}$ は $\alpha/\gamma$ 界面の易動度 $M^{3}$ 、Wおよび  $\varepsilon_{0}$ に関係付けられる phase field  $\phi$ の易動度であり  $M_{\phi}=M\sqrt{2W}/6\varepsilon_{0}$ と定義する.また、 $L'(\phi,u_{c},T)$ は炭素 原子の拡散係数を表現し、Fe-C合金のモル体積 $v_{m}$ 、炭素 原子が占有していない副格子の分率、すなわち空格子濃 度 $y_{V}$ 、炭素原子の易動度 $M_{c}$ および温度に関係付けられる.本研究では炭素原子の拡散係数が相の種類に依存 して界面領域で滑らかに変化するものと仮定し、次式を 用いる.

$$L'(\phi, u_{C}, T) = u_{C} y_{V} M_{C}$$
  
=  $u_{C} \left\{ p(\phi) \left( 1 - \frac{u_{C}}{3} \right) + \left\{ 1 - p(\phi) \right\} \left( 1 - u_{C} \right) \right\} \left( M_{C}^{\alpha} \right)^{p(\phi)} \left( M_{C}^{\gamma} \right)^{1 - p(\phi)}$   
(6)

なお、数値シミュレーションにおいては、式(4)および式 (5)の時間発展方程式を、時間に関してはクランク・ニコ ルソン中央差分法、空間に関してはアダプティブ有限要 素法<sup>4)</sup>を用いて離散化し、数値解析を行う.

#### 3 解析モデル

図1に本研究で用いた解析モデルおよび初期条件を示 す.解析領域は一辺が 1µmの正方形領域とし、γ粒界に 生成されたAllotriomorphフェライトを想定して、x軸上に 初期α相を配置する.このとき、Allotriomorphフェライト の初期α/γ界面形状がWidmanstättenフェライトの形成 過程および形態に及ぼす影響を検討するため、初期α/ γ界面に初期不整がありy軸方向に凹凸を有する場合を 想定する.また、変態温度はT = 1000K一定、各相の初期 炭素濃度はα相で平衡組成、γ相においては過飽和状態と する.境界条件としては、x方向の解析領域端で周期境界 条件、y方向の解析領域端で零ノイマン条件を採用する. なお、数値シミュレーションで用いる物性値、パラメー タについては以下に示す値を用いている:界面幅 δ = 6dx = 20 nm、異方性モード k = 2、界面エネルギー $\sigma =$ 1.0 J/m<sup>2</sup>、優先成長方向 $\theta_0 = 70^\circ, \lambda = 0.1$ .



Fig.1 Simulation model and initial conditions.

### 4 解析結果

図2に異方性強度 $\xi$ = 0.6における Widmanstätten フェ ライトの形成過程を示す.成長初期段階では強い界面異 方性に起因して、組織全体の界面エネルギーを減少させ るように界面形状が変化し、鋭い先端形状を有するプレ ートのチップ部分が多数形成される.また、初期界面形 状においてy方向に大きい凸状箇所に形成されたチップ は炭素拡散領域の影響を受けにくいため、優先的にプレ ート形状へと成長することがわかる.400 $\mu$ s 以降におい ては、各プレートは定常成長し、一方向に大きく成長し た Widmanstätten フェライトプレートが形成されること がわかる.このとき、プレートに挟まれた $\gamma$ 相において は炭素濃度が増加しているため、未変態のまま残留する ことが観察される.

異方性強度 ξ = 0.4 の場合における α 相の成長過程を 図3に示す.ξ = 0.6 の場合と同様に、初期界面形状の凸 状箇所がプレート状 α 相の優先形成サイトとなる.しか しながら、異方性強度の減少によりプレート側面の界面 エネルギーが増加するため、プレート横方向への成長が 促進しプレート数は減少する.したがって、優先成長方 向への成長速度が減少していることがわかる.

さらに、図4に異方性強度が $\xi=0.3$ の場合における  $\alpha$ 相の成長過程を示す.異方性強度が小さい場合には、鋭 い先端形状を有するチップが形成されず、炭素拡散領域 の影響を受け、 $\alpha$ 相の成長は抑制される.したがって、 Widmanstätten フェライトは形成されず Allotriomorph フ ェライトが界面をより滑らかにするように成長するこ とがわかる. 以上の結果より、Allotriomorph フェライトから Widmanstätten フェライトが形成されるためには、強い 界面異方性と炭素拡散領域の影響を受けない鋭いチッ プ先端形状が形成される必要があることが示唆される. なお、異なる初期界面形状における Widmanstätten フェ ライトの形成過程や形態に及ぼす影響などのより詳細 な解析結果については講演会当日発表する.



Fig.2 Growth of Widmanstätten ferrite from disturbed  $\alpha / \gamma$  interface in the strength of anisotropy  $\xi = 0.6$ .



Fig.3 Growth of Widmanstätten ferrite from disturbed  $\alpha / \gamma$  interface in the strength of anisotropy  $\xi = 0.4$ .



0.0014 0.0351 0.0688 0.10 Carbon concentration u<sub>c</sub>

Fig.4 Growth of Allotriomorph ferrite from disturbed  $\alpha / \gamma$  interface in the strength of anisotropy  $\xi = 0.3$ .

### 参考文献

- 1) I. Loginova et al, Acta Mater., **51**, 1327 (2003).
- 2) T. Takaki, et al, J. Crystal Growth, **287**, 495 (2006).
- 3) J.J. Eggleston et al, Physica D, **150**, 91, (2001).
- 4) T. Takaki et al, J. Crystal Growth, 283, 263 (2005).